LIGHT REFLECTING FILM AND OPTICAL RECORDING INFORMATION MEDIUM USING THE SAME

Patent number:

JP6243509

Publication date:

1994-09-02

Inventor:

HARIGAI MASATO; KAGEYAMA YOSHIYUKI; IWASAKI

HIROKO; IDE YUKIO

Applicant:

RICOH KK

Classification:

- international:

G11B7/24; G02B5/08

- european:

Application number: JP19930054996 19930219 **Priority number(s):** JP19930054996 19930219

Report a data error here

Abstract of JP6243509

PURPOSE:To obtain a light reflecting film used for a rewritable high density optical recording medium by using an Ag alloy having a prescribed reflectance or above in a specified wavelength range and capable of controlling its heat conductivity. CONSTITUTION:This light reflecting film has >=75% reflectance and 0.30-3.2W/cm.k heat conductivity when a light source emitting light having such a short wavelength as 450-830nm is used. This light reflecting film is made of an Ag alloy selected among Ag-In, Ag-V and Ag-Nb each having >=75% reflectance in the wavelength range of 450-700nm and capable of freely controlling its heat conductivity according to the ratio in the compsn.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

The of the Said

(19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

FI

(11)特許出願公開番号

特開平6-243509

(43)公開日 平成6年(1994)9月2日

(51)Int.Cl.⁵

12.

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G 1 1 B 7/24

5 3 8 E 7215-5D

G 0 2 B 5/08 A 9224-2K

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-54996

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

(22)出願日

平成5年(1993)2月19日

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 針谷 眞人

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(72)発明者 彭山 喜之

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(72)発明者 岩崎 博子

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(74)代理人 弁理士 友松 英爾 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称 】 光反射膜及び該膜を用いた光記録情報媒体

(57)【要約】

【目的】 本発明の目的は、光源の短波長化による高密 度化した光記録媒体、特に書き換え可能なタイプの高密 度化光記録媒体に使用する光反射膜の提供にある。

【構成】 450≦λ≦830nmの波長の光に対し て、反射率が75%以上であり、かつ熱伝導率が0.3 0~3.2 w/cm·kの間で制御が可能なAg合金で 構成された光反射膜。

1

【特許請求の範囲】

11/2 1

【請求項1】 450≦λ≦830nmの波長の光に対 して、反射率が75%以上であり、かつ熱伝導率が0. 30~3.2w/cm・kの間で制御が可能なAg合金 で構成された光反射膜。

【請求項2】 前記Ag合金はAg-In, Ag-V, Ag-Nbよりなる群から選ばれたものである請求項1 記載の光反射膜。

【請求項3】 450≦λ≦830nmの波長の記録用 光源、該光源により相転移可能な記録層および請求項1 または2記載の光反射膜を有することを特徴とする光情 報記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】本発明は、光反射膜、特に光記録媒体用反 射膜に関する。

[0002]

【従来技術】現在は光メモリ用光源として830nmの 半導体レーザが主流であるが、近年光記録媒体の記録密 度の向上が検討されその1つの方法として記録用光源の 短波長化が検討されている。具体的には従来のIII-V 族を利用する半導体レーザの場合は第2高調波発生素子 を利用してその波長を半分にする方法(例えば830 n mの半導体レーザは、~420nmに短波長化できる) がある。また、II-VI族を利用した半導体レーザも19 91年に490 nmで発振に成功し各方面において研究 が活発化しており近い将来実用化に達するものと思われ る。一方、光記録媒体には入射光を有効に利用する為金 属反射片が設けられ、AuやA1など(特開昭59-2 10545)が用いられている。

[0003]

【目的】本発明の目的は、今後前記のような光源の短波 長化による高密度化した光記録媒体、特に書き換え可能 なタイプの高密度化光記録媒体に使用する光反射膜の提 供にある。

[0004]

【構成】本発明の特徴の1つは、短波長光源、特にその 波長が450nmから830nmの間の光源を使用した 場合に、前記波長範囲内で高い反射率と広い範囲で熱伝 用例として相変化形光記録媒体がある。近年の光記録媒 体の動向は書き換え可能なタイプへの移行と、より高密 度な記録容量実現の為への工夫へと開発が指向されてい る。前者の場合は光磁気方式と相変化方式がその代表で あり、後者の場合は光源の短波長化がその代表である。 現在、短波長化、髙温動作、大出力化、低消費電力化等 を目的とする高性能半導体の開発が盛んに行われてお り、これにより近い将来直接変調が可能な400mm台 の波長を光源とする高密度大容量の光記録媒体が実用可 能となるものと思われる。このような短波長の光源を光 50 合が挙げられ、この相転移により記録←→記録の消去を

記録媒体の光源に使用する光記録媒体の場合にも、この 波長域で高い反射率を有する反射膜を使用する必要があ る。さらに、該記録媒体が書き換え可能な相変化形タイ プの場合には、該反射膜は記録媒体の線速に応じて熱伝 導率を容易に制御することのできるものである必要があ る。しかしながら、現在とのような要件をすべて満足す る光記録媒体用の反射膜は開発されていない。本発明者 らは、Ag合金、特に特定組成のAg合金を使用するこ とにより、前記のような要件を満足する光記録媒体の反 射膜が提供されることを見出した。すなわち従来から反 射材料としては、Au, Ag, Cu, Alがよく知られ ているが、光源が短波長化するとAuの場合は、600 nmあたりから反射率の低下が始まる。また、Alの場 合は、波長域400≤λ≤830nmの間で反射率の低 下はないがその値は80%台でありAuに比較して低 い。一方、Agは波長域400≦λ≦830nmの間で 反射率90%以上の値を有するので前記のような短波長 光源用の反射材料としては、好ましい材料と言える。し かしながら光記録媒体特に相変化形光記録媒体にAgの 反射膜を利用すると、その熱伝導率が高いため、該光記 録媒体の使用目的によっては感度の低下が生ずる場合が ある。

【0005】本発明においては、Ag金属の合金化、特 に特定金属と組合わせたAg合金を光記録媒体の反射膜 材料として使用することにより、前記のような短波長光 源を使用する場合においても、高反射率を維持しなが ら、かつ熱伝導率を幅広い範囲で制御可能な反射膜、特 に書き換え可能な相変化形記録媒体用に好適な反射膜が 提供される。このような反射膜としては、450nm≦ 30 λ≦830nmのような短波長光源を使用した場合に、 75%以上の反射率と0.30~3.2w/cm・kの 間の熱伝導率を有するものが好ましい。本発明で使用す るAg合金としては、Ag-In, Ag-V, Ag-N b等が挙げられる。特に、これらの合金においては、I n, V, Nbの組成比を増加すれば熱伝導率を0.30 w/cm・k以下にする事が可能であるが、それに応じ て反射率も低下しλ = 4 5 0 n m において 7 5 % 以下に なり反射層としての機能を失う。この様な比較的熱伝導 率が低い反射層は線速を速くして使用する場合に適用で 導率制御が容易な反射膜の提供にあり、その好ましい応 40 きる。一方CD線速のように比較的遅い線速の場合はA g単独のように高い熱伝導率を有する反射層を使用する のがよい。従って、各種の線速に対応させる為から、熱 伝導率が0.30~3.2 w/cm·kの範囲のものが 好ましい。

> 【0006】本発明において、相変化形光記録媒体の記 録層としては、光の照射により光を吸収し、この吸収さ れた光が熱に変換されることにより、該記録層が相転移 するものがあげられる。このような相転移としては、例 えば、非晶状態←→結晶状態と記録層の状態と変える場

行うことができる。他の記録層の相変化の例としては、 熱を受けて相溶状態と相分離状態間の相変化を生ずるよ うなポリマーブレンドの例が挙げられる。

[0007]

【実施例】

実施例1

4インチのAgターゲット、該ターゲット上に厚み1mm, 5mm角のチップを1個および4個配してRfスパ*

*ッタ法により50mm角のガラス基板上にAg-In合金膜を1000Åの厚さ設けた。この時合金の組成比はターゲット上のInのチップ数をかえる事により調整した。そして得られたAg-In合金膜の分光反射率を350nmから850nmの波長域で測定した。さらにこの合金膜の電気伝導率を四端子法により求め、これよりウイーデマン・フランツ則から熱伝導率を求めた。

【表1】

表1 Ag-In膜の分光反射率と熱伝導率

(3)

分光反射率 (%)						熱伝導率
350nm	450nn	550nm	650nm	750nm	850nm	₩/cm - k
65.0%	85.0%	94. 0%	95. 0%	96.0%	96.0%	1.6
61.0%	82.0%	93.0%	95. 0%	95. 0%	95.0%	1.2
74.0%	94.0%	97.0%	97.0%	97.5%	98.0%	3. 2
	65.0% 61.0%	350nm 450nm 65.0% 85.0% 61.0% 82.0%	350nm 450nm 550nm 65.0% 85.0% 94.0% 61.0% 82.0% 93.0%	350nm 450nm 550nm 650nm 65.0% 85.0% 94.0% 95.0% 61.0% 82.0% 93.0% 95.0%	350nm 450nm 550nm 650nm 750nm 65.0% 85.0% 94.0% 95.0% 96.0% 61.0% 82.0% 93.0% 95.0% 95.0%	350nm 450nm 550nm 650nm 750nm 850nm 65.0% 85.0% 94.0% 95.0% 96.0% 96.0% 61.0% 82.0% 93.0% 95.0% 95.0% 95.0%

前記表1よりAg-In合金は450nmから850nmの間で80%以上の高い反射率を有すると同時に熱伝導率もIn濃度を調整する事により自由に制御する事がわかる。

【0008】実施例2

実施例1と同様な方法によりRfスパッタ法により50mm角のガラス基板上にAgおよびAg-V合金膜を1%

※000Aの厚さ設けた。この時合金の組成比は、実施例 1と同様にしてVのチップ数をかえることにより調整した。そして得られたAgおよびAg-V合金膜の分光反射率を350nmから850nmの波長域で測定した。 さらにこの合金膜の電気伝導率を四端子法により求めウイーデマン・フランツ則に従って熱伝導率を求めた。 【表2】

表2 Ag-V膜の分光反射率と熱伝導率

物性	分光反射率 (%)						熱伝導率
	350nm	450nn	550пл	650nm	750nm	850nm	₩/cm·k
Ag-V 膜					·		
(V チップ1ケ)	53.0%	80.0%	87.0%	89.0%	91.0%	91.0%	0.63
Ag-V 膜							
(₹チップ3ケ)	50.0%	75.0%	78.0%	81.0%	84.0%	85.0%	0. 33
Ag	74.0%	94.0%	97.0%	97.0%	97.5%	98.0%	3. 2

表2よりAg-V合金も450nmから850nmの間で高い反射率を有し、又熱伝導率もV濃度の調整により自由に制御可能な事がわかる。

【0009】実施例3

実施例1と同様な方法により50mm角のガラス基板上

にAg-Nb合金膜を1000Aの厚さで設けた。そして得られたAgおよびAg-Nb合金膜の分光反射率と熱伝導率を実施例1および2と同様な方法で求め、その結果を次表3に示す。

【表3】

6

5

表3 Ag-Nb膜の分光反射率と熱伝導率

物性	分光反射率 (%)						熱伝導率
	350nm	450mm	550nm	650пш	750 n m	850 n m	w/cm·k
Ag-Nb膜 (Nbチップ1ケ)	69.0%	83.0%	88. 0%	90.0%	92.0%	93. 0%	0.93
Ag-Nb膜 (Nbチップ3ケ)	55.0%	75.0%	79.0%	83. 0%	85.0%	86. 0%	0.68
Ag	74.0%	94.0%	97.0%	97.0%	97.5%	98.0%	3. 2

表3よりAg-Nb合金を利用した反射膜も450nm から850nmの間の光に対して75%以上の反射率を有すると同時に熱伝導もNb濃度の調整により自由に制御できる。

[0010]

. . 4. 4

【効果】本発明によると、波長域450nmから700*20 度が実現できる光記録媒体が提供される。

* nmの間で75%以上の反射率を有すると同時に合金組成比によりその熱伝導率を自由に制御することが可能なAg合金を利用した反射膜が提供され、また該反射膜を光記録媒体用反射膜として利用することにより、使用領域で高い反射率を有すると同時に使用目的に応じて高感度が実現できると記録媒体が提供される

フロントページの続き

(72)発明者 井手 由紀雄 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内